

Р. В. ВИТЕР, В. А. СМЫНТЫНА, Н. Г. ЕВТУШЕНКО, Л. Н. ФИЛЕВСКАЯ, В. В. КУРКОВ

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННО-КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКИХ ПЛЕНОК SnO_2

Исследовались особенности адсорбционных свойств тонких пленок SnO_2 , нанесенных методом ESP (electrostatic spray pyrolysis). Пленки наносились на поликристаллические и аморфные подложки. Получены температурные зависимости адсорбционной чувствительности и кинетических характеристик (время адсорбции) исследуемых пленок по отношению к парам этилового спирта.

1. Введение

Мониторинг газового состава окружающей среды, а также контроль влияния технологических процессов на состав атмосферы является одной из главных задач газового анализа. Среди существующих методов газового анализа наиболее перспективным представляется использование полупроводников, из-за низкой стоимости исходных материалов и совместимости датчиков с ЭВМ [1]. Потребности в контроле производственных процессов, связанных с изготовлением и применением этанола, соблюдении правил техники безопасности, обеспечения наркологической экспертизы определили спрос на средства диагностики — анализаторы и сигнализаторы наличия этанола в воздухе [4]. Перспектива применения этанола в качестве горючего для автомобилей повышает необходимость контроля его паров при хранении и использовании. Базовыми материалами для чувствительных элементов являются полупроводники на основе оксидов металлов, в особенности, такие как SnO_2 , TiO_2 , In_2O_3 и др. [2].

Свойства сенсоров зависят от природы полупроводникового материала, легирующих добавок, дисперсности исходного материала, технологического режима изготовления. Вышеперечисленные параметры формируют структуру и состояние поверхности полупроводника, которые определяют его адсорбционные свойства [3]. Различают толстопленочные и тонкопленочные технологии. Преимущества тонких пленок очевидны: высокая чувствительность и быстродействие. К недостаткам тонких пленок относят изменения их структуры под действием температуры [4].

Существует ряд методов синтеза тонких пленок оксидов металлов (ионно-плазменное, электронно-лучевое напыление, магнетронное распыление, высокочастотное катодное распыление и др.). Однако самыми простыми среди них являются химические методы нанесения — пиролиз металлоорганических соединений, пульверизация аэрозолей, химическое осаждение из газовой фазы. Нами исследованы характеристики адсорбции этилового спирта на поверхности тонких пленок двуокиси олова, полученных методом электро-спрей пиролиза (ESP).

2. Методика получения пленок и проведения исследований

Поскольку газовые сенсоры эксплуатируются при относительно высоких температурах и в различных газовых средах, подложки для них применяются, в основном, из высокоглиноземистой керамики [5]. В качестве подложек образцов нами были использованы керамические подложки размером $5 \times 7 \text{ mm}^2$ марки XC22, имеющие следующий состав: Al_2O_3 — 94%, SiO_2 — 2,76%, Cr_2O_3 — 0,49%, MnO — 2,35%. Выбор материала подложки обусловлен тем, что оксид алюминия инертен по отношению к воздуху, водяному пару, аргону, оксиду углерода и т. д. и термоустойчив в широком интервале температур (до 1800°C). При высоких температурах оксид алюминия выдерживает воздействие всех газов, за исключением фтора [6]. Перед нанесением слоев подложки обрабатывались в смеси серной и соляной кислот (раствор царской водки), раствором $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ в концентрированной серной кислоте, с последующей многократной промывкой в дистиллированной воде и сушкой в экскаторе с силикагелем. Контактные площадки изготавливались из платины и наносились через трафаретную маску методом термического напыления в вакууме на установке ВУП-5. Расстояние между контактами составляло 4 мм.

Образцы SnO_2 , полученные методом ESP (описан в [7]), представляли собой полупрозрачные тонкие пленки молочного цвета.

Образцы схематично изображены на рис. 1.

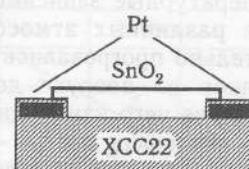


Рис. 1. Схема исследуемых образцов:

Pt — платиновые контакты;
 SnO_2 — слой двуокиси олова;
 XC22 — подложка

ной чувствительности и кинетических характеристик адсорбции пленок двуокиси олова.

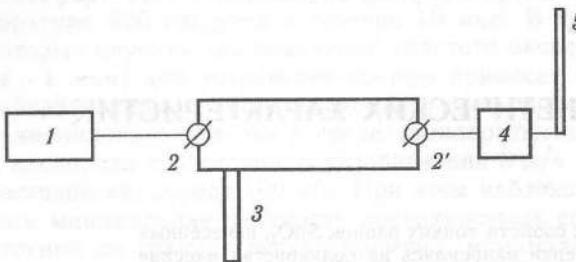


Рис. 2. Схема экспериментальной установки:

1 — компрессор; 2, 2' — трехходовые клапаны, 3 — емкость с парами этанола, 4 — измерительная камера, 5 — ротаметр

На рис. 3. изображена электрическая схема экспериментальной установки. С источника напряжения во внешнюю цепь подавалось напряжение $U = 5 \text{ В}$. Изменение падения напряжения на сопротивлении $R = 4000 \Omega$ регистрировалось с помощью графопостроителя.

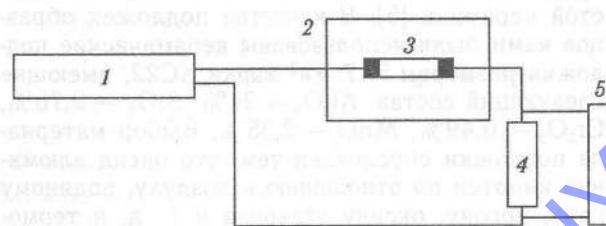


Рис. 3. Электрическая схема экспериментальной установки:

1 — источник напряжения БП-8; 2 — измерительная камера; 3 — исследуемый образец; 4 — сопротивление; 5 — графопостроитель

Расчет концентрации этанола осуществлялся следующим образом:

1. Был определен расход этанола l/c (объем спирта, который уносится воздухом за 1 секунду) и рассчитано число молекул этанола N_e , содержащихся в этом объеме.

2. Зная расход воздуха (по показаниям ротаметра) можно подсчитать N_a — число молекул воздуха. Концентрация паров этанола c , определенная по формуле $c = N_e/N_a \cdot 10^6$, была постоянной и составляла 267 ppm.

В ходе эксперимента были исследованы температурные зависимости темнового тока (ТЗТТ) в различных атмосферах. Образцы предварительно прогревались до 670 К, а затем охлаждались на воздухе до комнатной температуры. После чего измерялись зависимости ТЗТТ. ТЗТТ в атмосфере воздух + спирт измерялась следующим образом: образец нагревали на воздухе до 873 К, напускали спирт и охлаждали до комнатной температуры. После этого измерялись зависимости ТЗТТ.

Для изучения влияния кислорода на поверхностные процессы цикл исследований ТЗТТ завершался очисткой поверхности, которая заключалась в последовательном прогреве и охлаждении образца в атмосфере аргона. После очистки

поверхности в камеру снова напускался воздух при $T = 873 \text{ К}$. После охлаждения до комнатной температуры образец нагревали на воздухе до 873 К, напускали спирт и охлаждали до комнатной температуры. Затем измерялись зависимости ТЗТТ.

Экспериментальные результаты

Энергии активации проводимости определялись из ТЗТТ, графики которых изображены на рис. 4. На графике заметны три характерных участка: a — рост тока с ростом температуры до 540 К, b — аномальная зависимость тока от температуры в интервале 540...750 К, c — незначительный рост тока с температурой. Максимум тока достигается при $T = 540 \text{ К}$, минимум — при 750 К. Перестроив зависимость в координатах $\ln I \sim 1/T$ [9] определили энергии активации на участке a : $E_{a_1} = 0,039 \text{ эВ}$, $E_{a_2} = 0,13 \text{ эВ}$.

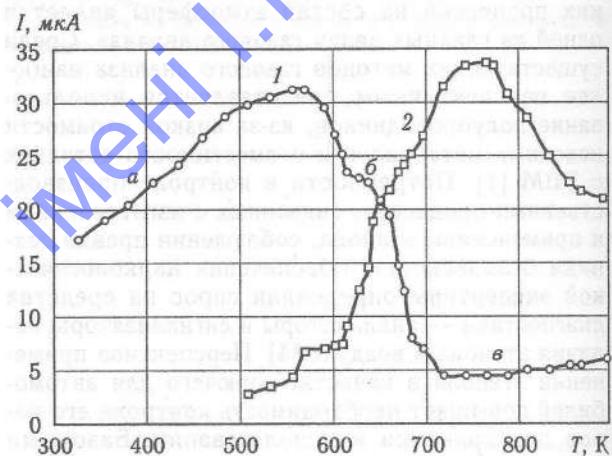


Рис. 4. Температурная зависимость темнового тока до отжига на воздухе (1) и в атмосфере спирта (2):

участок a — термический выброс с донорных центров; b — аномальная температурная зависимость, c — полное заполнение центров адсорбции ионами однократно ионизированного кислорода O^-

В атмосфере спирт + воздух форма кривой не изменяется. Также наблюдается аномальный ход ТЗТТ, максимум проводимости смещается в сторону более высоких температур. Проводимость образца в спиртосодержащей атмосфере увеличивается. Соответствующие энергии активации проводимости составляют $E_{a_1} = 0,07 \text{ эВ}$, $E_{a_2} = 0,21 \text{ эВ}$.

В ходе эксперимента были исследованы зависимости от температуры адсорбционной чувствительности (АЧ) γ , времени адсорбции и времени десорбции паров этанола на поверхности исследуемых образцов.

Адсорбционная чувствительность образцов γ определялась из следующего соотношения:

$$\gamma = U_{\text{gas}} / U_{\text{air}},$$

где U_{gas} — падение напряжения на нагрузочном сопротивлении в случае атмосферы воздух + этанол, U_{air} — падение напряжения на нагрузочном сопротивлении в случае атмосфере воздуха.

График температурной зависимости АЧ в атмосфере паров спирта до отжига изображен на рис. 5.

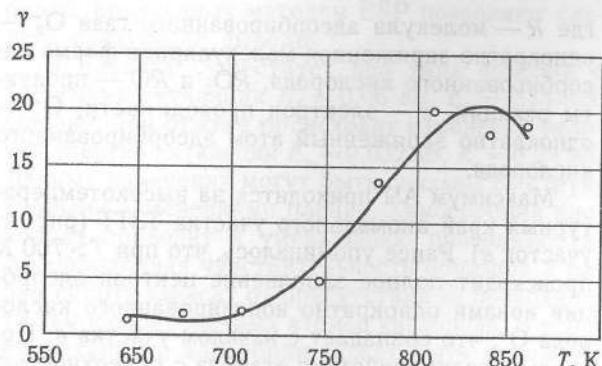


Рис. 5. Характерная температурная зависимость адсорбционной чувствительности образцов до отжига

Как видно из рис. 5, чувствительность возрастает в интервале температур 600...750 К и достигает максимума при $T = 750$ К, что соответствует температуре максимума на кривой $I(T)$. При дальнейшем росте температуры величина газовой чувствительности уменьшается. Графики температурной зависимости времен адсорбции t_a и десорбции t_d в атмосфере паров спирта изображены на рис. 6. Кривая $t_a(T)$ проходит через максимум при $T = 700$ К с последующим убыванием. Температура минимума t_a совпадает с температурой максимума для АЧ. Время десорбции монотонно убывает с ростом T .

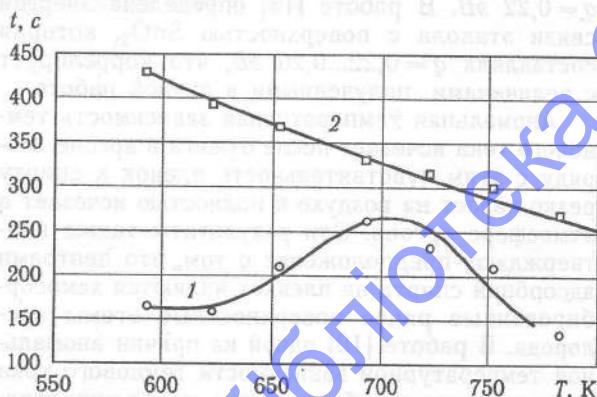


Рис. 6. Температурная зависимость времен адсорбции (1) и времен десорбции (2) до отжига

Представляло интерес выяснить, как изменяются характеристики образца после очистки поверхности. Графики ТЗТТ образца после отжига в аргоне представлены на рис. 7.

Исследование особенностей кривых ТЗТТ показали, что при каждом последующем отжиге область аномальной зависимости уменьшалась, а при 4-м цикле исчезла полностью. При этом энергии активации ТЗТТ в аргоне (кривая 1) составляли $E_{a_1} = 0,06$ эВ, $E_{a_2} = 0,14$ эВ. После совершения циклов прогрева в аргоне в камеру напускался воздух (кривая 2). Проводимость при этом резко падала, что может свидетельствовать о хемосорбции кислорода. Аномальной

зависимости темнового тока не наблюдалось. Энергии активации ТЗТТ на воздухе составляли $E_{a_1} = 0,032$ эВ, $E_{a_2} = 0,24$ эВ.

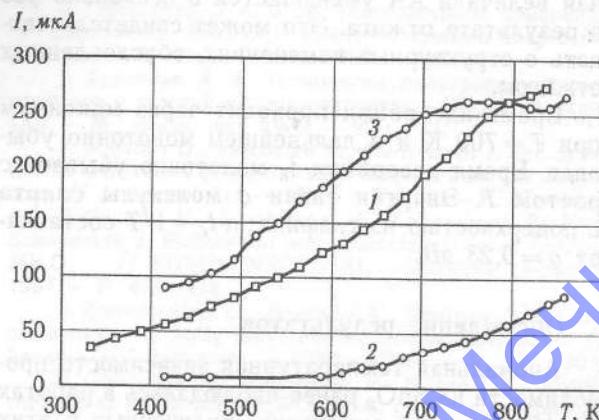


Рис. 7. Температурная зависимость темнового тока после отжига:

1 — в аргоне; 2 — на воздухе; 3 — в атмосфере паров спирта

Кривая 3 представляет собой ТЗТТ в атмосфере воздух + спирт. При напуске спирта наблюдалось резкое увеличение проводимости. Энергии активации ТЗТТ в спиртосодержащей атмосфере составляли $E_{a_1} = 0,08$ эВ, $E_{a_2} = 0,13$ эВ.

Графики температурных зависимостей АЧ, времен адсорбции и десорбции в атмосфере паров спирта после отжига в аргоне изображены на рис. 8 и 9 соответственно.

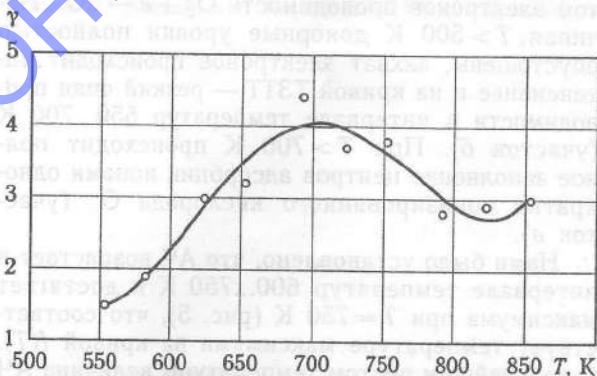


Рис. 8. Температурная зависимость АЧ при 5 В после отжига в аргоне при $T = 870$ К в течение 1 ч

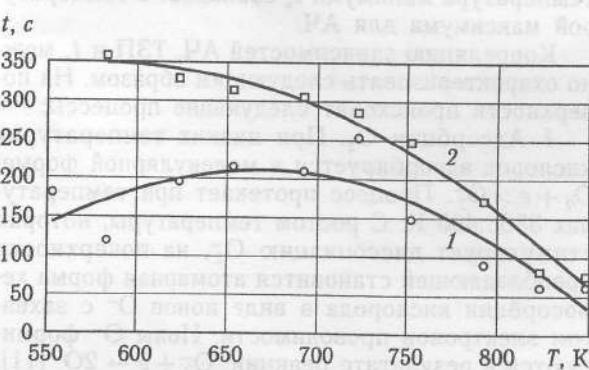


Рис. 9. Температурная зависимость времен адсорбции (1) и десорбции (2) после отжига в Ar при $T = 870$ К в течение 1 ч

Отжиг приводит к тому, что T_{\max} АЧ смещается в сторону более низких температур и достигает максимума при $T = 700$ К. Максимальная величина АЧ уменьшается в несколько раз в результате отжига. Это может свидетельствовать о структурных изменениях, обусловленных отжигом.

Время адсорбции проходит через максимум при $T = 700$ К и в дальнейшем монотонно убывает. Время десорбции t_d монотонно убывает с ростом T . Энергии связи q молекулы спирта с поверхностью из графика $\ln t_d \sim 1/T$ составляют $q = 0,23$ эВ.

Обсуждение результатов

Аномальная температурная зависимость проводимости на SnO_2 ранее наблюдалась в работах [9, 10]. Энергии активации, полученные в этих работах составляли $E_{a_1} = 0,04$ эВ, $E_{a_2} = 0,13$ эВ. Данные энергии активации связывают соответственно с однократно и двукратно заряженными вакансиями кислорода V_O и V_O^{2-} .

Механизм аномальной зависимости проводимости от температуры (рис. 4, кривая 1) может трактоваться следующим образом: в интервале температур 300...500 К происходит термический выброс электронов с донорных центров биографического происхождения, предположительно вакансий кислорода (участок *a*). При $T > 400$ К [11] происходит превращение адсорбированного молекулярного кислорода в атомарный, с захватом электронов проводимости $O_2^- + e \rightarrow 2O^-$. Начиная $T > 500$ К донорные уровни полностью опустошены, захват электронов происходит интенсивнее и на кривой ТЗТТ — резкий спад проводимости в интервале температур 550...700 К (участок *b*). При $T > 700$ К происходит полное заполнение центров адсорбции ионами однократно ионизированного кислорода O^- (участок *c*).

Нами было установлено, что АЧ возрастает в интервале температур 600...750 К и достигает максимума при $T = 750$ К (рис. 5), что соответствует температуре максимума на кривой $I(T)$. С дальнейшим ростом температуры величина АЧ уменьшается. Кривая $t_a(T)$ проходит через максимум при $T = 650$ К с последующим убыванием. Температура минимума t_a совпадает с температурой максимума для АЧ.

Корреляцию зависимостей АЧ, ТЗП и t_a можно охарактеризовать следующим образом. На поверхности происходят следующие процессы:

1. Адсорбция O_2 . При низких температурах кислород адсорбируется в молекулярной форме: $O_2 + e \rightarrow O_2^-$. Процесс протекает при температурах 350...400 К. С ростом температуры, которая стимулирует диссоциацию O_2^- , на поверхности преобладающей становится атомарная форма хемосорбции кислорода в виде ионов O^- с захватом электронов проводимости. Ионы O^- формируются в результате реакции: $O_2^- + e \rightarrow 2O^-$ [11].

2. Адсорбция спирта. Установлено [12], что спирт адсорбируется на кислородных атомах, ранее хемосорбированных на поверхности. Здесь

спирт связывает кислород и способствует его десорбции:



где R — молекула адсорбированного газа O_2^- — однократно заряженная молекулярная форма адсорбированного кислорода, RO_2 и RO — продукты реакции, e — электрон проводимости, O^- — однократно заряженный атом адсорбированного кислорода.

Максимум АЧ приходится на высокотемпературный край аномального участка ТЗТТ (рис. 4, участок *c*). Ранее упоминалось, что при $T > 700$ К происходит полное заполнение центров адсорбции ионами однократно ионизированного кислорода O^- , что совпадает с началом участка *c*. Поскольку взаимодействия этанола с поверхностью присходит при участии хемосорбированного кислорода, можно предположить, что при предельной концентрации O^- на поверхности скорость реакции взаимодействия этанола с поверхностью будет максимальной. В результате поверхностной реакции увеличивается концентрация электронов проводимости, что отражается на величине АЧ. При дальнейшем увеличении температуры вероятность десорбции возрастает и могут происходить структурные изменения, а значит, количество электронов проводимости уменьшается. Этот процесс сопровождается увеличением t_a и уменьшением АЧ.

Время десорбции монотонно убывает с ростом температуры. Предполагая, что $t_d \sim e^{-q/kT}$ [3], из графика $\ln t_d \sim 1/T$ определили энергию связи $q = 0,22$ эВ. В работе [13] определена энергия связи этанола с поверхностью SnO_2 , которая составляла $q = 0,22 \dots 0,26$ эВ, что коррелирует с величинами, полученными в данной работе.

Аномальная температурная зависимость темнового тока исчезает после отжига в аргоне. Наряду с этим чувствительность пленок к спирту резко падает на воздухе и полностью исчезает в атмосфере аргона. Эти результаты также подтверждают предположение о том, что центрами адсорбции спирта на пленках являются хемосорбированные ранее поверхностные атомы кислорода. В работе [10] одной из причин аномальной температурной зависимости темнового тока считались хемосорбированные на межкристаллитных границах атомы кислорода. Отжиг образцов в аргоне приводит к десорбции кислорода с поверхности, что и отражается на чувствительности к спирту. Кроме того, при высоких температурах происходят необратимые изменения чувствительного слоя вследствие укрупнения размеров кристаллитов за счет перекристаллизации мелких кристаллитов. Отжиг приводит к уменьшению плотности межкристаллитных прослоек и других поверхностных дефектов, которые служат центрами адсорбции кислорода. При этом уменьшаются размеры эффективной поверхности пленки, что приводит к изменению ее адсорбционных свойств [14]. Следствием этих процессов является также и уменьшение адсорбционной чувствительности исследуемых пленок.

Заключение

Проведенные исследования проводимости и адсорбционных характеристик пленок двуокиси олова, полученных методом ESP позволяют сделать следующие выводы.

В пленках существует два типа доноров с энергиями активации $E_{a_1} = 0,06$ эВ, $E_{a_2} = 0,14$ эВ. Однако, при отжиге происходят изменения величин энергий активации $E_{a_1} = 0,032$ эВ, $E_{a_2} = 0,24$ эВ. Данные изменения могут быть связаны со структурными изменениями пленки. Хемосорбция кислорода приводит к уменьшению проводимости. Адсорбционная чувствительность образцов к парам спирта зависит от присутствия на поверхности хемосорбированных атомов кислорода. В основу механизма адсорбции может быть положено взаимодействие молекул этанола с кислородом, хемосорбированным ранее на поверхности.

Отжиг образцов в атмосфере инертного газа приводит к уменьшению величины газовой чувствительности и исчезновению аномальной температурной зависимости темнового тока. Это явление может быть связано с уменьшением концентрации центров адсорбции для кислорода. Существенную роль в этих процессах могут играть структурные факторы.

Литература

1. Bergveld P. Chemically sensitive electronic devices ... Proc. of the 2nd int. meeting on chemical sensors. — Bordeaux, 1986. — Р. 49—53.
2. Ириха В. Полупроводниковые газовые сенсоры. Обзор. — Одесса, 1996. — 99 с.

3. Волькенштейн Ф. Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при хемосорбции. — М.: Наука, 1987. — 432 с.

4. Приборы, средства автоматизации и системы управления. — Вып. 2. — М., 1990. — С. 5—8.

5. Геращенко О. А. и др. Температурные измерения // Справочник. АН УССР. Институт проблем энергосбережения. — К.: Наук. думка, 1989. — 704 с.

6. Куркосов А. И. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. — Кн. 2. Материалы. — М.: Высш. шк., 1989. — 96 с.: ил.

7. Meesters G., Vercoulen P., Marijnissen I. and Scartell B. Generation of micron sited droplets from the Taytor cone // J. Aerosol Sci. — 1992. — Vol 23. — P. 37—49.

8. Gourari H., Llumbreras M., Landschoot R., Van Schoonman J. Elaboration and characterization of $\text{SnO}_2\text{—Mn}_2\text{O}_3$... // EURUSENSORS XI. — Warshaw (Poland), 1997. — P. 475—478.

9. Korotchenkov G., Brynzari V., Dmitriev S. Electrical behavior of SnO_2 thin films in humid atmosphere // Sensors and Actuators. — 1999. — B 54. — P. 197—201.

10. Golovanov V., Smyntyna V., Brinzari V., Korotchenkov G. Cd_xS- and Sn_xWO_y-based gas sensors: the role of chemical composition in CO sensing // Photoelectronics. — 2001. — Vol. 10. — P. 6—11.

11. Kissine V. V., Sysoev V. V., Voroshilov S. A. Conductivity of SnO_2 thin films in the presence of surface adsorbed species // Sensors and Actuators. — 2001. — B. 4017. — P. 1—8.

12. Saha M., Banerjee A., Halder A. K., Mondal J., Sen A., Maiti H. S. Effect of alumina addition on methane sensitivity of tin dioxide thick films // Sensors and Actuators. — 2001. — B. 4025. — P. 1—4.

13. Sakai Go, Matsunag Naoki, Shimane Kengo, Yamazoe Noboru. Theory of gas-diffusion controlled sensitivity for thin film semiconductor gas sensor // Sensors and Actuators. — 2001. — B. 4041. — P. 1—7.

14. Cabot A., Dieguez A., Romano-Rodriguez A., Morante J. R., Barsan N. Influence of the catalytic introduction procedure on the nano-SnO₂ gas sensor performances // Sensors and Actuators. — 2001. — B. 4008. — P. 1—9.

Наукова бібліотека ОДУ